

15³⁰ – 15⁴⁵

***В.Л. Кошевой¹, А.О. Белорус², В.С. Левицкий²,
Е.И.Теруков³, Н.С. Пщелко¹, В.А. Мошников².***

Исследование фазового состава тонких плёнок mс-Si:H и рn-Si:H полученных методом PECVD при различных технологических параметрах осаждения. ¹Национальный Минерально-Сырьевой университет “Горный”, Санкт-Петербург, Россия. ² Санкт-Петербургский Электротехнический университет “ЛЭТИ”, факультет электроники, Санкт-Петербург, Россия. ³НТЦ тонкопленочных технологий в энергетике при ФТИ имени А.Ф. Иоффе, Санкт – Петербург, Россия.

15⁴⁵ – 16⁰⁰

О.И. Семенова, Е.С. Юданова. Тонкопленочные солнечные элементы. Новые тенденции. *Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова, Новосибирск, Россия.*

16⁰⁰ – 16¹⁵ – перерыв 15 минут

16¹⁵ – 17¹⁵ - Стендовая секция – 2

17¹⁵ – **Заккрытие конференции**